









	<h2 style="color: red;">SI4808DY-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4808DY-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4808DY-T1-E3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 18578 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4808DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	18578 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A

SI4808DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4808DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4808DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4808DY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4808DY-T1</b> SILICNI SI4808DY-T1 SILICNI</p>	 <p><b>SI4807DY-T1</b> SILICON SI4807DY-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI4810ADY</b> VISHAY SI4810ADY VISHAY</p>	 <p><b>SI4810BD</b> VISHAY SI4810BD VISHAY</p>
 <p><b>SI4807DY-T1-E3</b> VISHAY SI4807DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4808DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4808DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4808DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>

### SI4808DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	SI4808DY-T1-E3	SI4808DY-T1-E3	SI4808DY-T1-E3	SI4808DY-T1-E3
SI4808DY-T1-E3 / Siliconix	SI4808DY-T1-E3 Datenblatt	SI4808DY-T1-E3-Datenblätter	SI4808DY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4808DY-T1-E3
SI4808DY-T1-E3 Electronic	SI4808DY-T1-E3-Komponenten	SI4808DY-T1-E3-Verteiler	SI4808DY-T1-E3-Bild	SI4808DY-T1-E3-Teil
SI4808DY-T1-E3 Preis	SI4808DY-T1-E3 Hersteller	SI4808DY-T1-E3 Bild	SI4808DY-T1-E3 Aktie	SI4808DY-T1-E3 Inventar
SI4808DY-T1-E3 Neu	SI4808DY-T1-E3 Original	SI4808DY-T1-E3 garantiert	SI4808DY-T1-E3 RFQ	SI4808DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited